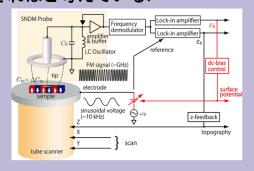
長 康雄 氏

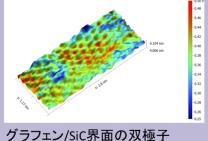
(東北大学 未来科学技術共同研究センター)



走査型プローブ顕微鏡が切り拓く表面科学と 電子デバイス応用への展開 ・走査型非線形銹電率顕微鏡を中心として。

走査型トンネル顕微鏡が発明されて以来多くの走査型プローブ顕微鏡が開発され表面科学の発展に大きな足跡を残してきたことは周知の事である。その中でも近年は電気計測に特化した走査型プローブ顕微鏡を用いた電子材料・デバイス計測・評価とその応用への関心が高まっている。本講演では講演者独自の発明の静電容量顕微鏡である走査型非線形誘電率顕微鏡(SNDM)を中心に置き、これを用いた原子スケール誘電計測や誘電体・半導体材料・素子評価技術、更には次世代超大容量ハードディスクドライブ実現を目指した超高密度強誘電体記録応用への展開について、研究の楽しさ苦しさ研究者の夢を交えてお話しできればと考えている。





グラフェン/SiC界面の双極子 由来電位分布の可視化

→参加登録はこちら→



3月 **11**日 (月) 17:00-18:30

武蔵野大学有明キャンパス,4号館411教室,ハイブリッド開催 参加ご希望の方は,右上のQRコードより参加登録をお願いいたします. 参加費無料 登録締切:3/10(日)

国際展示場駅 徒歩7分 東京ビッグサイト駅 徒歩6分



コーディネーター: 時弘 哲治(武蔵野大学工学部数理工学科 教授)

問い合わせ先: 武蔵野大学数理工学センター

https://www.musashino-u.ac.jp/research/laboratory/mathematical_engineering/

